

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年7月25日(2013.7.25)

【公開番号】特開2012-99598(P2012-99598A)

【公開日】平成24年5月24日(2012.5.24)

【年通号数】公開・登録公報2012-020

【出願番号】特願2010-245149(P2010-245149)

【国際特許分類】

H 01 L 21/28 (2006.01)

H 01 L 29/78 (2006.01)

H 01 L 29/12 (2006.01)

H 01 L 21/336 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/28 3 0 1 B

H 01 L 29/78 6 5 3 A

H 01 L 29/78 6 5 2 T

H 01 L 29/78 6 5 2 M

H 01 L 29/78 6 5 8 F

H 01 L 21/28 3 0 1 R

【手続補正書】

【提出日】平成25年6月12日(2013.6.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 5】

上述したように、Ni原子およびSi原子を有する電極(電極層)の形成に際して、電極層の電気伝導度を高くするためには、Niの割合を高める必要がある。しかしNiの割合が高められると、電極層形成のためのアニールの際に、炭化珪素基板から電極層の表面へと多くのC原子が析出してしまう。このため、電極層の電気伝導度を高くすることと、電極層の表面へのC原子の析出の抑制とを両立させることが困難であった。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 5】

上述したように本発明によれば、電極層の電気伝導度を高めることと、電極層の表面へのC原子の析出の抑制とを両立させることができる。